

Type

Operational Data

Maximum Ratings

KC507
KC508
KC509

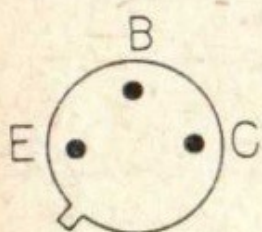
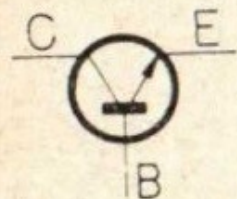
KC507 KC508 KC509

measured at

KC507 KC508
KC509

U_{CB0}	> 45	> 20	> 20 V	$I_{CB0}=15$ nA
U_{CEO}	> 45	> 20	> 20 V	$I_{CEO}=2$ mA
U_{EBO}	> 5	> 5	> 5 V	$I_{EBO}=1$ μ A
I_{B1}	< 0,5	< 0,5	< 0,25 μ A	} $U_{CE}=5$ V, $I_E=10$ μ A
h_{21E}	> 20	> 20	> 40	
I_{B2}	< 16	< 16	< 16 μ A	} $U_{CE}=5$ V, $I_E=2$ mA
I_{B3}	70	70	40 μ A	
h_{21E}	285	285	500	} $U_{CE}=5$ V, $I_C=20$ mA
I_{B4}	600	600	400 μ A	
U_{CES}	< 0,25	< 0,25	< 0,25 V	$I_C=10$ mA, $I_B=0,5$ mA
U_{CES}	< 0,6	< 0,6	< 0,6 V	$I_C=100$ mA, $I_B=5$ mA
$ h_{21e} $	> 1,5	> 1,5	> 1,5	$U_{CE}=5$ V, $I_C=10$ mA, $f=100$ MHz
h_{21e}	125 ..	125 ..	240 ..	$U_{CB}=5$ V, $-I_E=2$ mA, $f=1$ kHz
C_{CB}	< 4,5	< 4,5	< 4,5 pF	$U_{CB}=10$ V, $f=1$ MHz
F	< 10	< 10	- dB	$U_{CE}=5$ V, $I_C=0,2$ mA, $R_G=2$ k Ω , $f=1$ kHz, $\Delta f=200$ Hz
F	-	-	< 4 dB	$U_{CE}=5$ V, $I_C=0,2$ mA, $R_G=2$ k Ω , $f=30$ Hz ... 15 kHz

U_{CB0}	45	20	V
U_{CBM}	45	20	V
U_{CEO}	45	20	V
U_{EBO}	5	5	V
U_{EBM}	5	5	V
I_C	100	100	mA
I_{CM}	200	200	mA
$I_{CM imp}$	200	200	mA
$-I_E$	100	100	mA
$-I_{EM}$	200	200	mA
I_B	15	15	mA
i_{BM}	20	20	mA
P_C	300	300	mW
T_j	+175	+175	$^{\circ}$ C
T_1	-55...+175	-55...+175	$^{\circ}$ C
R_{t1}	200	200	$^{\circ}$ C/W



Silicon n-p-n epitaxial planar transistors for A. F. pre-stages

Outlines K 507